

2SA1365

大電流ドライブ用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

2SA1365は、超小形外形樹脂封止形シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタでコレクタ電流が大きく、 $V_{CE(sat)}$ が小さく設計、製造されております。2SC3440とコンプリメンタリで使用できます。

特長

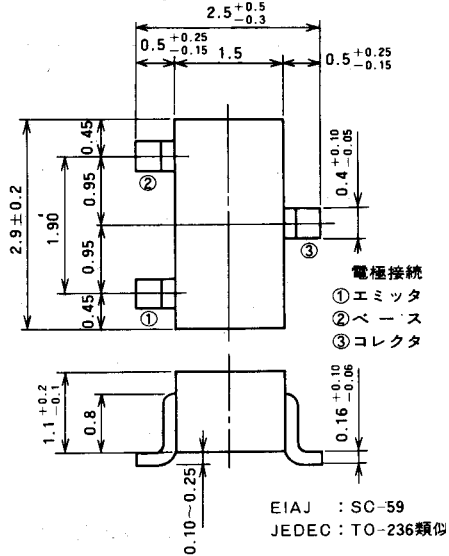
- 小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- コレクタ電流が大きく $I_{CM} = -1000\text{mA}$
- $V_{CE(sat)}$ が小さい $V_{CE(sat)} = -0.2\text{V}$ 標準
- 直流電流増幅率の直線性がよい
- 利得帯域幅積が高い $f_T = 180\text{MHz}$ 標準

用途

小形モータドライブ、リレードライブ、電源用

外形図

単位：mm

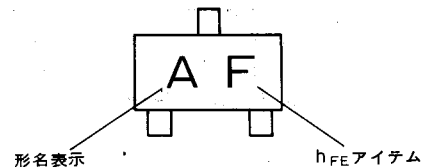


(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-25	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-4	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-20	V
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-1000	mA
I_C	コレクタ電流	-700	mA
P_C	コレクタ損失 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	150	mW
T_j	接合部温度	125	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

マーク図



電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-25			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-4			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -100\mu\text{A}, R_{BE} = \infty$	-20			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -25\text{V}, I_E = 0$			-1	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -2\text{V}, I_C = 0$			-1	μA
h_{FE}	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -100\text{mA}$	150		800	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -25\text{mA}$		-0.2	-0.5	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE} = -6\text{V}, I_E = 10\text{mA}$		180		MHz

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

マーキング	AE	AF	AG
h_{FE}	150~300	250~500	400~800